

Nチャンネル型MOS-FET(ゲート保護DI有り品)

小型PKG (SC-59) Nch MOS-FET大電流製品群を開発中!

INKxxxxC1 series

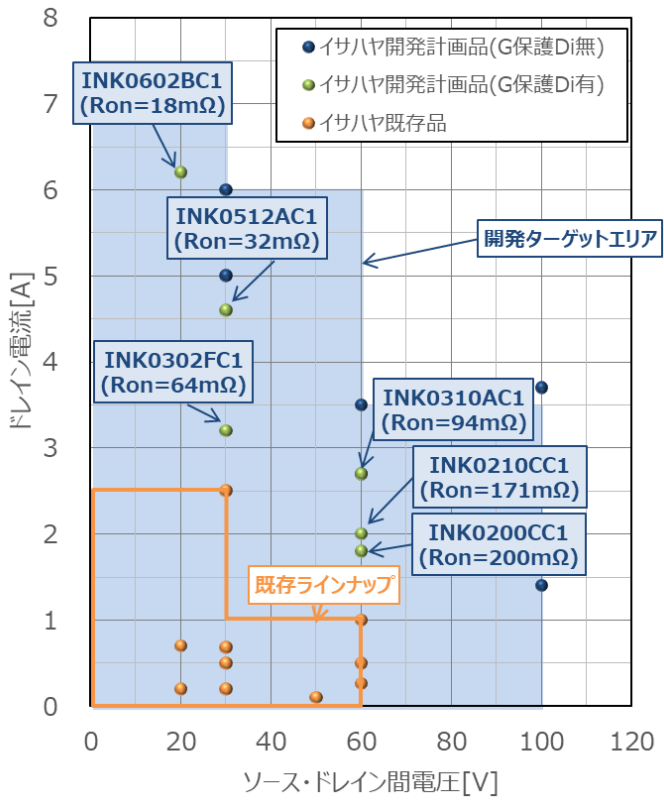
※車載対応品も順次展開予定です。

開発中

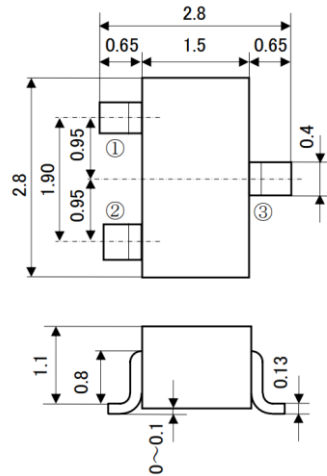
□概要

当社の小型PKG(SC-59) Nチャンネル型MOS-FETラインナップに当社では今までになかった大電流で使用できる製品を新たに追加いたしました。追加開発品種においては、下記特性早見表および互換表をご確認ください。

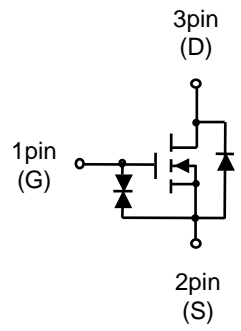
□耐圧-電流マップ



□外形図 単位(mm)



□等価回路



※ゲート保護DI有り

□互換表

形名	VDSS [V]	ID [A]	RDS(on) [mΩ]	極性	リリース時期			他社相当品	
					ES	CS	MP	T社	R社
INK0602BC1	20	6.2	18*	Nch	NOW	'23/5	TBD	SSM3K345R	RUR040N02
INK0302FC1	30	3.2	64	Nch	NOW	'23/8	TBD	SSM3K336R	RQ5E025SN
INK0512AC1	30	4.6	32	Nch	NOW	TBD	TBD	SSM3K14T	RQ5E035XN
INK0210CC1	60	2	171	Nch	NOW	'23/5	TBD	SSM3K2615R	RQ5L020SN
INK0200CC1	60	1.8	200	Nch	NOW	TBD	TBD	SSM3K2615R	RQ5L020SN
INK0310AC1	60	2.7	94	Nch	NOW	'23/2	TBD	SSM3K318R	RQ5L030SN

※RDS(on)は、標準値を記載しております。
 ※RDS(on)の測定条件は VGS=10V(*は4.5V), ID=(各機種に記載されたID) となります。
 ※熱許容損失(P_D)は基板実装時 0.9W となります。